

Silicon NPN Transistor

2N3708

30V / 30mA / 250mW

DATASHEET

OEM – Texas Instruments

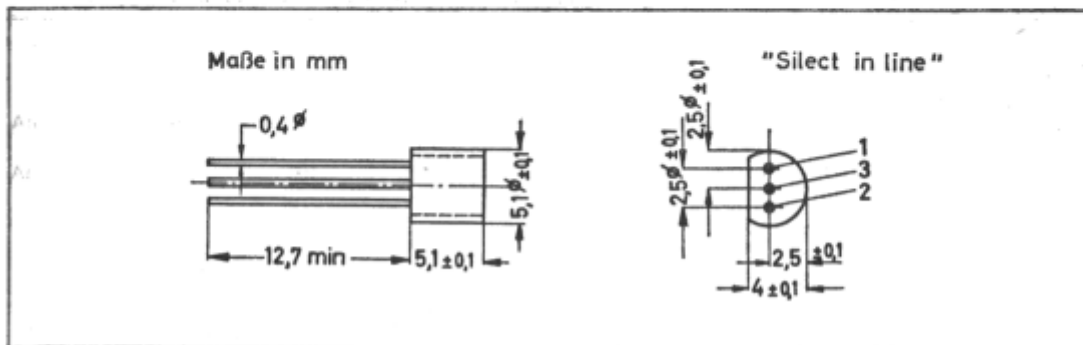
Source: Texas Instruments Databook 1968/69

NPN-Silizium-Planar-Transistoren im Silect*-Gehäuse

Vorverstärker und Kleinsignal — Anwendungen mit geringem Rauschen (2N3707)

Für allgemeine Kleinsignal-Anwendungen mit hoher Verstärkung (2N3711)

Mechanische Daten 2N3707, 2N3708, 2N3709, 2N3710, 2N3711



1 — Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollektor

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehäuse eingekapselt. Das Gehäuse widersteht Löttemperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen ausgezeichnet stabile Kennwerte und erfüllen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Absolute Grenzwerte**

Kollektor-Basis-Spannung	30 V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1)	30 V
Emitter-Basis-Spannung	6 V
Kollektorstrom	30 mA
Dauer-Verlustleistung bei (oder darunter) $T_U = 25\text{ °C}$ (Bem. 2)	250 mW
Lagerungs-Temperaturbereich	-55 °C bis +150 °C
Temperatur der Anschlüsse 1,5 mm vom Gehäuse (10 s Dauer)	260 °C

Bemerkungen:

1. Dies gilt für offene Basis.
2. Lineare Abnahme bis $T_U = 125\text{ °C}$ mit $2,5\text{ mW/°C}$.

* Schutzmarke von Texas Instruments.

** JEDEC registriert.

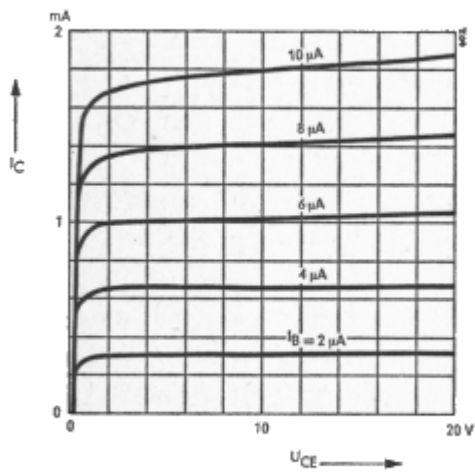
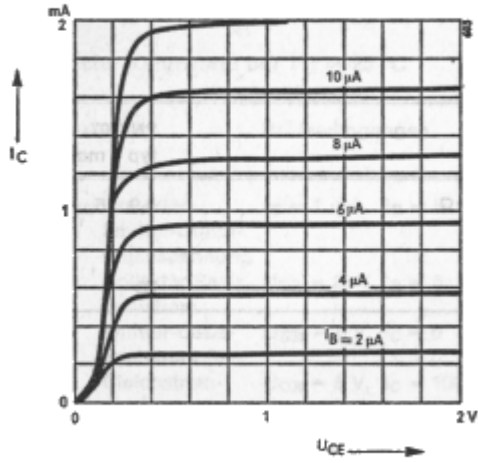
Elektrische Kennwerte bei $T_U = 25\text{ °C}$

Parameter	Prüfbedingungen	2N3707		2N3708		2N3709		2N3710		2N3711		Einheit
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	
$U_{(BR)CEO}$ Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung	$I_C = 1\text{ mA}, I_B = 0$	30		30		30		30		30		V
I_{CBO} Kollektor-Basis-Reststrom	$U_{CB} = 20\text{ V}, I_E = 0$	100		100		100		100		100		nA
I_{EBO} Emitter-Basis-Reststrom	$U_{EB} = 6\text{ V}, I_C = 0$	100		100		100		100		100		nA
h_{FE} Gleichstromverstärkung	$U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$ $U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 1\text{ mA}$	100	400	45	660	45	165	90	330	180	660	
U_{BE} Basis-Emitter-Spannung	$U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 1\text{ mA}$	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	V
$U_{CE(sat)}$ Kollektor-Emitter-Restspannung	$I_B = 0,5\text{ mA}, I_C = 10\text{ mA}$	1		1		1		1		1		V
h_{21e} Kurzschluß-Stromverstärkung	$U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 100\text{ }\mu\text{A},$ $f = 1\text{ kHz}$ $U_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 1\text{ mA},$ $f = 1\text{ kHz}$	100	550	45	800	45	250	90	450	180	800	

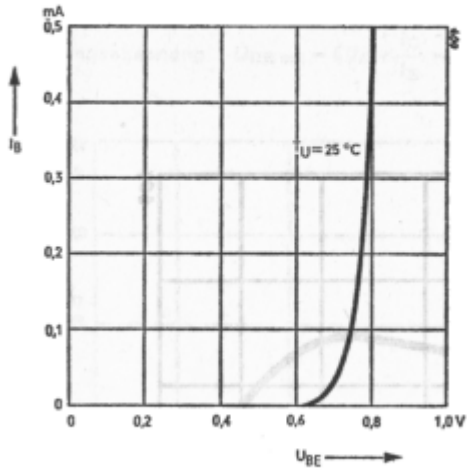
Betriebswerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$

Parameter	Prüfbedingungen	2N3707 typ max	Ein- heit
F	mittl. Rauschfaktor $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 100\ \mu\text{A}$, $R_G = 5\ \text{k}\Omega$ 10 Hz ... 10 kHz äquivalente Bandbreite = 15,7 kHz	1,9 5	dB
f_T	Transitfrequenz $U_{CE} = 5\text{ V}$, $I_C = 1\ \text{mA}$	80	MHz

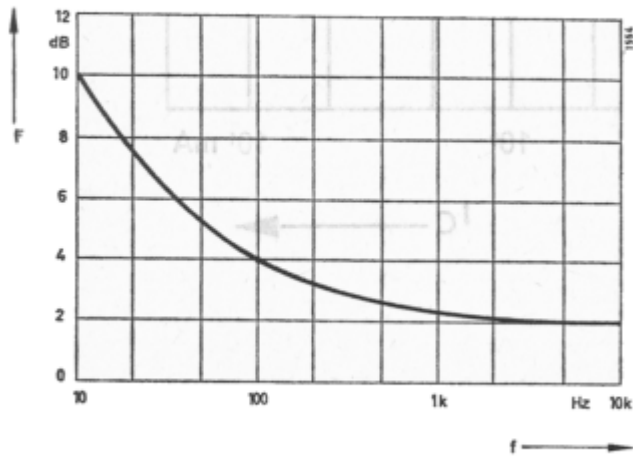
Ausgangskennlinien $I_C = f(U_{CE})$; $I_B = \text{Parameter}$; $T_V = 25^\circ\text{C}$; (Emitterschaltung)



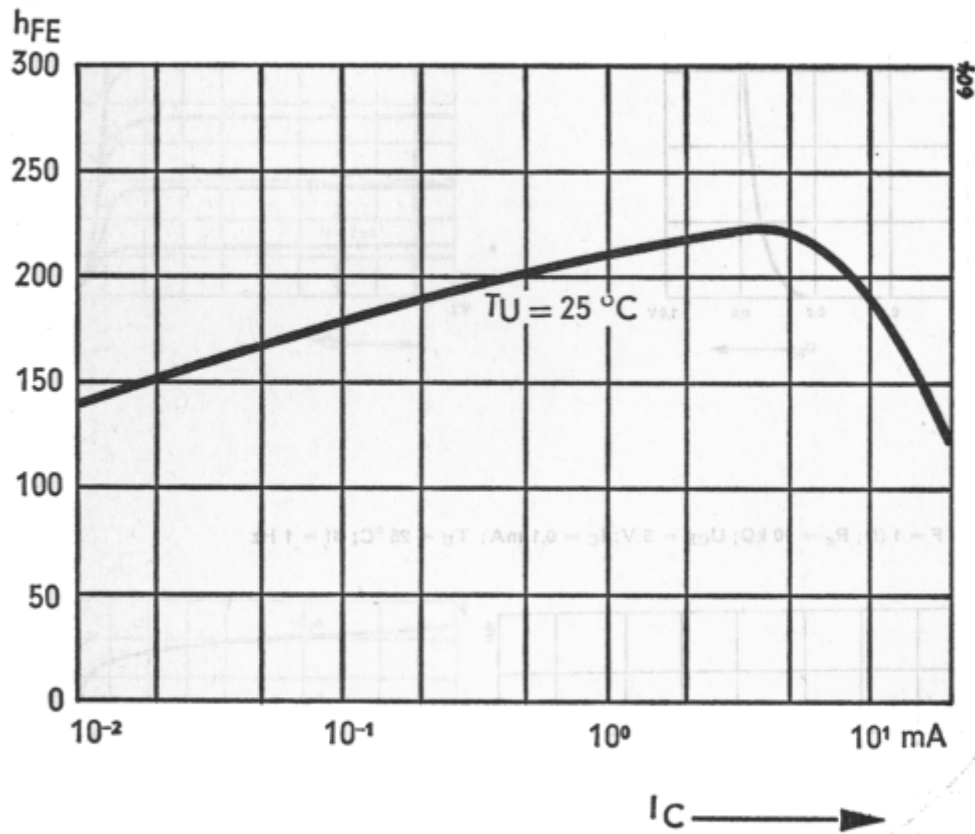
Eingangskennlinie $I_B = f(U_{BE})$; $U_{CE} = 5\text{ V}$; (Emitterschaltung)



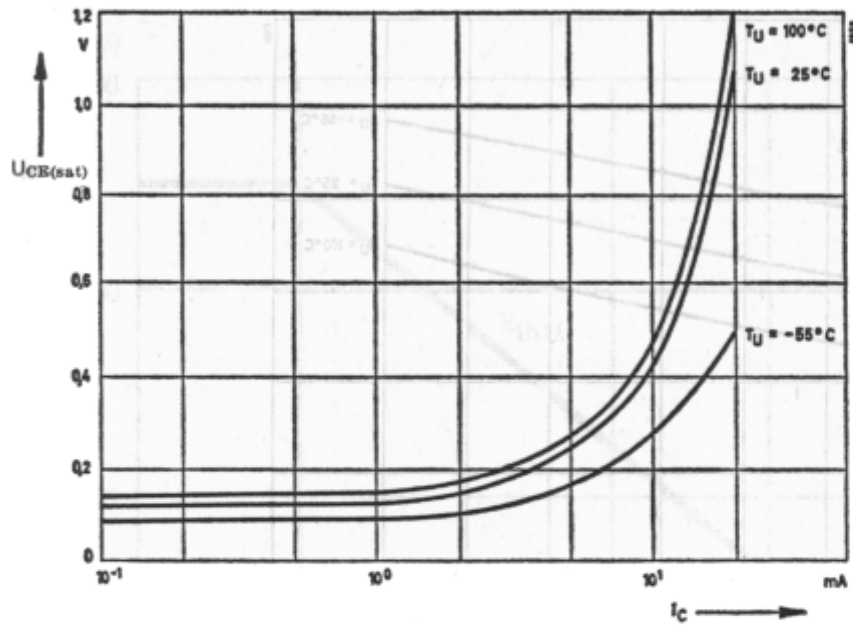
Rauschfaktor $F = f(f)$; $R_g = 10\text{ k}\Omega$; $U_{CE} = 5\text{ V}$; $I_C = 0,1\text{ mA}$; $T_U = 25^\circ\text{C}$; $\Delta f = 1\text{ Hz}$



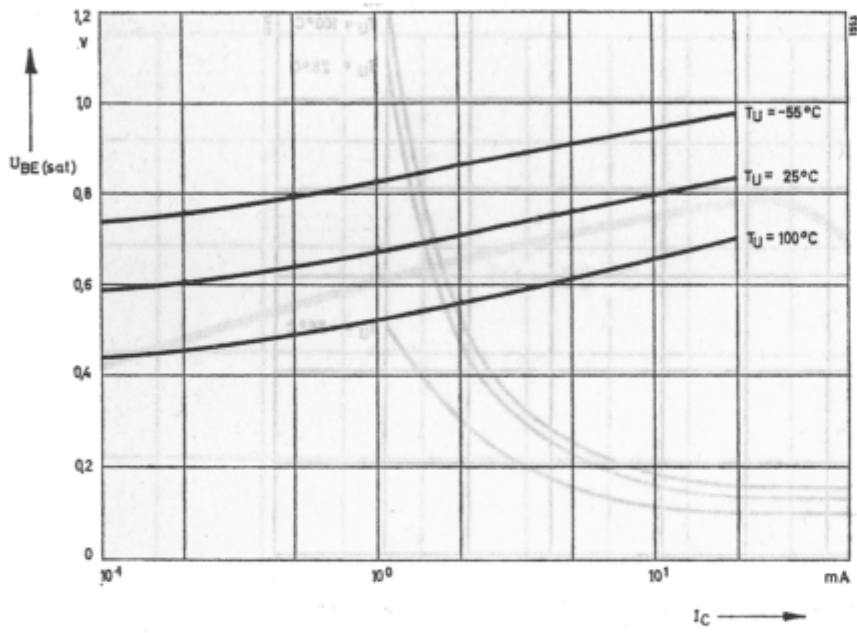
Stromverstärkung $h_{FE} = f(I_C)$; $U_{CE} = 5\text{ V}$; (Emitterschaltung)



Sättigungsspannung $U_{CE\ sat} = f(I_C); \frac{I_C}{I_B} = 20; T_U = \text{Parameter}; (\text{Emitterschaltung})$



Sättigungsspannung $U_{BE\ sat} = f(I_C); \frac{I_C}{I_B} = 10; T_U = \text{Parameter}; (\text{Emitterschaltung})$



Temperaturabhängigkeit der zulässigen Gesamtverlustleistung;
 $P_{tot} = f(T_U)$

